

(51)Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
G 0 2 F	1/1343	G 0 2 F 1/1343
1/1333	5 0 5	1/1333 5 0 5
1/1335	5 2 0	1/1335 5 2 0
1/136	5 0 0	1/136 5 0 0
G 0 9 F	9/30	G 0 9 F 9/30 3 4 8 A

審査請求 有 請求項の数3 O L (全17頁)

(21)出願番号	特願平10-172595
(62)分割の表示	特願平4-240935の分割
(22)出願日	平成4年(1992)9月9日
(31)優先権主張番号	特願平3-230608
(32)優先日	平3(1991)9月10日
(33)優先権主張国	日本 (J P)
(31)優先権主張番号	特願平3-316667
(32)優先日	平3(1991)11月29日
(33)優先権主張国	日本 (J P)
(31)優先権主張番号	特願平4-177096
(32)優先日	平4(1992)7月3日
(33)優先権主張国	日本 (J P)

(71)出願人	000005049 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(72)発明者	三ツ井 精一 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤープ株式会社内
(72)発明者	木村 直史 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤープ株式会社内
(72)発明者	中村 久和 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤープ株式会社内
(74)代理人	弁理士 梅田 勝

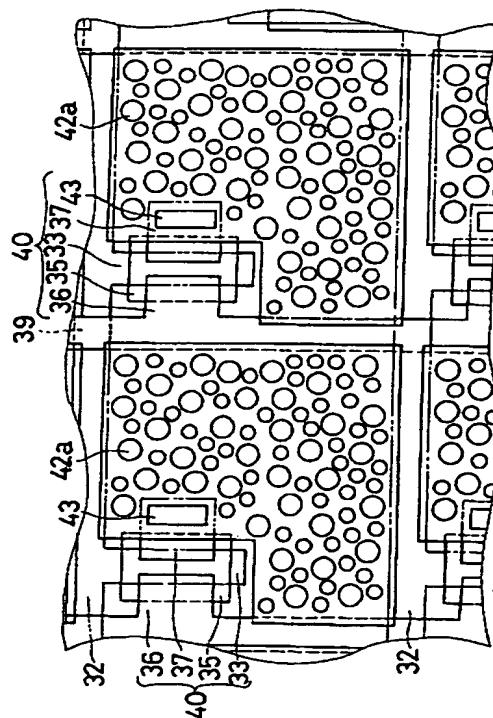
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 反射型液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 良好な反射特性を有する反射板を容易に、かつ再現性よく作成することができ、表示品位が向上する反射型液晶表示装置およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 液晶層を介在して対向配置される一対の基板のうちの一方側の基板上に、絶縁膜を介して、他方基板側からの入射光を反射する反射電極が形成される反射型液晶表示装置において、前記絶縁膜は、凹凸を有する有機樹脂からなるとともに、該凹凸の配列パターンが、少なくとも2つ以上の前記反射電極の形成領域において同一であることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶層を介在して対向配置される一対の基板のうちの一方側の基板上に、絶縁膜を介して他方基板側からの入射光を反射する反射電極が形成される反射型液晶表示装置において、前記絶縁膜は、凹凸を有する有機樹脂からなるとともに、該凹凸の配列パターンが、少なくとも2つ以上の前記反射電極の形成領域において同一であることを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項2】 前記絶縁膜に形成された凹凸の配列パターンが、全ての前記反射電極の形成領域において同一であることを特徴とする請求項1記載の反射型液晶表示装置。

【請求項3】 液晶層を介在して対向配置される一対の基板のうちの一方側の基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射電極を有する反射型液晶表示装置の製造方法において、

前記一方基板上の液晶層側に感光性樹脂を塗布する工程と、

前記感光性樹脂を略円形のパターンが不規則に配列された遮光手段を介して露光および現像した後に熱処理を行い、複数の凹凸部を形成する工程と、

前記複数の凹凸部上に金属薄膜からなる前記反射電極を形成する工程と、を含み、前記遮光手段に配列された略円形のパターンの総面積が、前記反射電極の総面積の40%以上であることを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、外部からの入射光を反射することによって表示を行う反射型液晶表示装置およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、ワードプロセッサ、ラップトップ型パーソナルコンピュータ、ポケットテレビなどへの液晶表示装置の応用が急速に進展している。特に、液晶表示装置の中でも外部から入射した光を反射させて表示を行う反射型液晶表示装置は、バックライトが不要であるため消費電力が低く、薄形であり、軽量化が可能であるため注目されている。

【0003】 従来から、反射型液晶表示装置にはTN(ツイステッドネマティック)方式、ならびにSTN(スーパツイステッドネマティック)方式が用いられているけれども、これらの方では偏光板によって必然的に自然光の光強度の1/2が表示に利用されないことになり、表示が暗くなるという問題がある。

【0004】 このような問題に対して、偏光板を用いず、自然光の全ての光線を有効に利用しようとする表示モードが提案されている。このようなモードの例として、相転移型ゲスト・ホスト方式が挙げられる(D.

L. White and G. N. Taylor: J. Appl. Phys. 45 4718 1974)。このモードでは、電界によるコレステリック・ネマティック相転移現象が利用されている。この方式に、さらにマイクロカラーフィルタを組合せた反射型マルチカラーディスプレイも提案されている(Tohru Koizumi and Tatsuo Uchida Proceedings of the SID. Vol. 29/2. 157. 1988)。

【0005】 このような偏光板を必要としないモードでさらに明るい表示を得るために、あらゆる角度からの入射光に対し、表示画面に垂直な方向へ散乱する光の強度を増加させる必要がある。そのためには、最適な反射特性を有する反射板を作成することが必要となる。上述の文献には、ガラスなどから成る基板の表面を研磨剤で粗面化し、フッ化水素酸でエッチングする時間によって表面の凹凸を制御し、その凹凸上に銀の薄膜を形成した反射板について記載されている。

【0006】 しかしながら、上記文献に記載の反射板には、ガラス基板に研磨剤によって傷をつけることによって凹凸が形成されるため、均一な形状の凹凸が形成されない。また、凹凸の形状の再現性が悪いという問題があるため、このようなガラス基板を用いると再現性よく良好な反射特性を有する反射型液晶表示装置を提供することができない。

【0007】 図25は、アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ(以下、「TFT」と記す。)1を有する基板2の平面図であり、図26は、図25に示す切断面線X26-X26から見た断面図である。ガラスなどの絶縁性の基板2上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線3が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線3からはゲート電極4が分岐して設けられている。ゲートバス配線3は、走査線として機能している。

【0008】 ゲート電極4を覆って基板2上の全面に窒化シリコン(SiN_x)、酸化シリコン(SiO_x)などから成るゲート絶縁膜5が形成されている。ゲート電極4の上方のゲート絶縁膜5上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す。)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層6が形成されている。半導体層6の一方の端部には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極7が重疊形成されている。また、半導体層6の他方の端部には、ソース電極7と同様に、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極8が重疊形成されている。ドレイン電極8の半導体層6とは反対側の端部には、ITO(Indium Tin Oxide)から成る絵素電極9が重疊形成されている。

【0009】 図25に示すように、ソース電極7にはゲートバス配線3と前述のゲート絶縁膜5を挟んで交差す

るソースバス配線10が接続されている。ソースバス配線10は、信号線として機能している。ソースバス配線10も、ソース電極7と同様な金属で形成されている。ゲート電極4、ゲート絶縁膜5、半導体層6、ソース電極7およびドレイン電極8は、TFT1を構成し、該TFT1はスイッチング素子の機能を有している。

【0010】図25および図26に示すTFT1を有する基板2を反射型液晶表示装置に適用しようすれば、絵素電極9をアルミニウム、銀などの光反射性を有する金属で形成するばかりでなく、ゲート絶縁膜5あるいはその上に凹凸を形成する必要がある。一般に、無機物から成る絶縁膜にテープのついた凹凸を均一に形成することは困難である。

【0011】図27は、アクティブマトリクス方式に用いられるTFT11を有する基板12の平面図であり、図28は、図27に示される切断面線X28-X28から見た断面図である。ガラスなどの絶縁性の基板12上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線13が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線13からはゲート電極14が分岐して設けられている。ゲートバス配線13は、走査線として機能している。

【0012】ゲート電極14を覆って基板12上の全面に、窒化シリコン、酸化シリコンなどから成るゲート絶縁膜15が形成されている。ゲート電極14の上方のゲート絶縁膜15上には、a-Siなどから成る半導体層16が形成されている。半導体層16の両端部には、a-Siなどから成るコンタクト層17が形成されている。一方のコンタクト電極17上にはソース電極18が重疊形成され、他方のコンタクト層17上には、ドレイン電極19が重疊形成されている。ソース電極18には、ゲートバス配線13と前述のゲート絶縁膜15を挟んで交差する信号線として機能するソースバス配線23が接続されている。ゲート電極14、ゲート絶縁膜15、半導体層16、コンタクト層17、ソース電極18およびドレイン電極19は、TFT11を構成する。

【0013】さらにその上に複数の凸部20aを有し、ドレイン電極19上にコンタクトホール21を有する有機絶縁膜20が形成される。有機絶縁膜20上には、反射電極22が形成され、反射電極22はコンタクトホール21を介してドレイン電極19と接続されている。

【0014】以上のように、TFT11を形成した基板12上有機絶縁膜20を形成する場合は、エッチング法を用いて有機絶縁膜20の表面に凸部20aを容易に形成することができ、凸部20aを有する有機絶縁膜20上に反射電極22を形成することによって、容易に凹凸を有する反射電極22を形成することができる。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】図25および図26に示されるように、反射電極9とソースバス配線10とをゲート絶縁膜5上に形成する際には、反射電極9とソ

ースバス配線10とが導通しないように間隙9aが形成される。しかしながら、図27および図28に示されるように、ソースバス配線23をゲート絶縁膜15上に、反射電極22を有機絶縁膜20上にそれぞれ形成すれば、前述のような間隙9aは不要である。

【0016】表示の輝度を向上するためには、反射電極22はその表面積が大きいほど好ましい。したがって、図27および図28では反射電極22端部は、有機絶縁膜20を介してソースバス配線23上に形成されている。

【0017】有機絶縁膜20は、凸部20aを有しているため、隣り合う凸部20a間の底部20b部分がソースバス配線23上に接触するエッチング不良が生じた場合、有機絶縁膜20による絶縁が行われず、有機絶縁膜20上に形成される反射電極22とソースバス配線23との絶縁不良が生じるという問題がある。

【0018】また、基板12上の全面に凸部20aを有する有機絶縁膜20を形成するため、反射電極22をパターニングする際、凸部20aによって反射電極22の周縁部に凹凸が生じ、反射電極22のパターニング不良が生じるという問題がある。

【0019】さらに、反射電極22が、基板12上に形成された引回し電極であるゲート電極14上の接続部分の半導体層16の上に有機絶縁膜20を介して形成された場合、反射電極22にかかる信号が半導体層16にかかり、疑似的に反射電極22がゲート電極14と同じような機能を果たし、反射電極22と半導体層16との界面にチャネルを形成してしまい、TFT11の特性を低下させる。また、ゲート電極14と反射電極22との間に、大きな寄生容量が発生することになる。これらの現象は、表示品位を低下させる原因となる。

【0020】本発明の目的は、上述の問題を解決し、良好な反射特性を有する反射板を容易に、かつ再現性よく作成することができ、表示品位が向上する反射型液晶表示装置およびその製造方法を提供することである。

【0021】

【課題を解決するための手段】本発明は、液晶層を介在して対向配置される一対の基板のうちの一方側の基板上に、絶縁膜を介して他方基板側からの入射光を反射する反射電極が形成される反射型液晶表示装置において、前記絶縁膜は、凹凸を有する有機樹脂からなるとともに、該凹凸の配列パターンが、少なくとも2つ以上の前記反射電極の形成領域において同一であることを特徴とする反射型液晶表示装置である。

【0022】また、本発明は、前記絶縁膜に形成された凹凸の配列パターンが、全ての前記反射電極の形成領域において同一であることを特徴とする。

【0023】本発明は、液晶層を介在して対向配置される一対の基板のうちの一方側の基板上に、他方基板側からの入射光を反射する反射電極を有する反射型液晶表示

装置の製造方法において、前記一方基板上の液晶層側に感光性樹脂を塗布する工程と、前記感光性樹脂を略円形のパターンが不規則に配列された遮光手段を介して露光および現像した後に熱処理を行い、複数の凹凸部を形成する工程と、前記複数の凹凸部上に金属薄膜からなる前記反射電極を形成する工程と、を含み、前記遮光手段に配列された略円形のパターンの総面積が、前記反射電極の総面積の40%以上であることを特徴とする反射型液晶表示装置の製造方法である。

【0024】以下、本発明の反射型液晶表示装置およびその製造方法について、その作用を簡単に説明する。

【0025】本発明に従えば、反射型液晶表示装置は、前記凹凸部の配列パターンが同一である反射電極を有しており、そのため、反射電極毎に異なる配列パターンで形成する必要はなく、反射電極が形成される全領域に容易に前記凹凸部を形成することが可能となる。つまり、反射電極に対応する領域のホトマスク上には、それぞれ同じ配列パターンで遮光領域が形成されるため、一つの反射電極に対応する配列パターンを形成するだけでも、ホトマスクの作成が容易に可能となっている。

【0026】また本発明に従えば、反射型液晶表示装置の製造方法において、前記遮光手段は、前記略円形のパターンが形成された遮光領域の総面積を反射電極の総面積の40%以上としているため、高い反射率を得ることが可能となる。つまり、遮光手段の遮光領域の総面積を反射電極の総面積の40%以上とすることにより、正反射成分が多くならず、散乱が多くなるために、観察者の視角範囲において高い反射率を得ることが可能となっている。

【0027】

【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施形態である反射型液晶表示装置30の断面図であり、図2は、図1に示される基板31の平面図である。ガラスなどから成る絶縁性の基板31上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線32が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線32からはゲート電極33が分岐している。ゲートバス配線32は、走査線として機能している。

【0028】ゲート電極33を覆って基板31上の全面に、窒化シリコン(SiN_x)、酸化シリコン(SiO_x)などから成るゲート絶縁膜34が形成されている。ゲート電極33の上方のゲート絶縁膜34上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層35が形成されている。半導体層35の両端部には、a-Siなどから成るコンタクト電極41が形成されている。一方のコンタクト電極41上には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極36が重疊形成され、他方のコンタクト電極41上には、ソース電極36と同様に、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成る

ドレイン電極37が重疊形成されている。

【0029】図2に示すように、ソース電極36には、ゲートバス配線32に前述のゲート絶縁膜34を挟んで交差するソースバス配線39が接続されている。ソースバス配線39は、信号線として機能している。ソースバス配線39も、ソース電極36と同様の金属で形成されている。ゲート電極33、ゲート絶縁膜34、半導体層35、ソース電極36およびドレイン電極37は、薄膜トランジスタ(以下、「TFT」と記す)40を構成し、該TFT40はスイッチング素子の機能を有する。

【0030】ゲートバス配線32、ソースバス配線39およびTFT40を覆って、基板31上全面に有機絶縁膜42が形成されている。有機絶縁膜42の反射電極43が形成される領域には、先細状で先端部が球面状に形成された、高さHの凸部42aが形成されており、ドレイン電極37の部分にはコンタクトホール43が形成されている。有機絶縁膜42の形成方法や、これにコンタクトホール43を形成する工程上の問題、および液晶表示装置30を作成する際の液晶層厚のバラツキを小さくするため、凸部42aの高さHは10μm以下が好ましい。

【0031】一般に、液晶層の厚さは10μm以下である。有機絶縁膜42の凸部42a形成領域上にアルミニウム、銀などから成る反射電極38が形成され、反射電極38はコンタクトホール43において、ドレイン電極37と接続される。さらにその上には、配向膜44が形成される。

【0032】基板45上には、カラーフィルタ46が形成される。カラーフィルタ46は、基板31の反射電極38に対向する領域には、マゼンタまたは緑色のフィルタ46aが形成され、反射電極38に対向しない領域には黒色のフィルタ46bが形成される。カラーフィルタ46上の全面には、ITO(Indium Tin Oxide)などから成る透明電極47が形成され、さらにその上には配向膜48が形成される。

【0033】前記両基板31、45は、反射電極38とフィルタ46aとが一致するよう対向して貼合わせられ、基板間に液晶49が注入されて反射型液晶表示装置30が完成する。

【0034】図3は、図1および図2に示される凹凸を有する反射電極38を基板31上に形成する形成方法を説明する工程図であり、図4は、図3に示す形成方法を説明する断面図であり、図5は、図3の工程s7で用いられるマスク51の平面図である。図4(1)は、図3の工程s4を示し、図4(2)は、図3の工程s7を示し、図4(3)は、図3の工程s8を示し、図4(4)は、図3の工程s9を示している。

【0035】工程s1では、ガラスなどから成る絶縁性の基板31上にスパッタリング法によって3000Åの厚さのタンタル金属層を形成し、この金属層をホトリソ

グラフ法およびエッティングによってパターニングを行い、ゲートバス配線32およびゲート電極33を形成する。工程s2では、プラズマCVD法によって4000Åの厚さの窒化シリコンから成るゲート絶縁膜34を形成する。

【0036】工程s3では、半導体層35となる厚さ1000Åのa-Si層と、コンタクト層41となる厚さ400Åのn⁺型a-Si層とをこの順で連続的に形成する。形成されたn⁺型a-Si層およびa-Si層のパターニングを行い、半導体層35およびコンタクト層41を形成する。工程s4では、基板31の全面に厚さ2000Åのモリブデン金属をスパッタ法によって形成し、このモリブデン金属層のパターニングを行って、ソース電極36、ドレイン電極37およびソースバス配線39を形成し、TFT40が完成する。図4(1)は、工程s4までの処理終了後のTFT40が形成された基板31の断面図である。

【0037】工程s5では、TFT40を形成した基板31上の全面にポリイミド樹脂を2μmの厚さに形成し、有機絶縁膜42を形成する。工程s6では、ホトリソグラフ法およびドライエッティング法を用いて有機絶縁膜42にコンタクトホール43を形成する。工程s7では、有機絶縁膜42上にホトレジスト50を塗布し、図5に示されるマスク51を用いて反射電極38形成領域に凸部50aをパターニングする。さらに、凸部50aの角をとるために、120℃～250℃の範囲で熱処理を行う。本実施の形態では、200℃、30分の熱処理を行った。図4(2)に、工程s7までの処理終了後の基板31の断面図を示す。マスク51には、反射電極38形成領域に、図5に示されるように斜線で示す円形の遮光領域51aが不規則に形成されている。

【0038】工程s8では、図4(3)に示されるように、ホトレジスト50を覆って有機絶縁膜42をエッティングして高さHが0.5μmの凸部42aを形成する。このとき、ホトレジスト52に熱処理を行い、凸部50aの角をとるために、凸部42aもまた角がとれた形に形成される。また、コンタクトホール43およびTFT40上の有機絶縁膜42は、ホトレジスト50によって保護されており、エッティングは行われない。

【0039】工程s9では、有機絶縁膜42上全面にアルミニウム層を形成し、図4(4)に示されるように凸部42a上に反射電極38を形成する。この状態の基板31を、反射電極38を有する基板52とする。反射電極38は、有機絶縁膜42に形成されたコンタクトホール43を介してTFT40のドレイン電極37と接続されている。

【0040】有機絶縁膜42上の凸部42aの形状は、マスク51の形状、ホトレジスト50の厚さ、ドライエッティングの時間によって制御することができることが確認されている。

【0041】以上の工程によって、反射電極38を有する基板52を得た。また、上述の製造工程において、有機絶縁膜42のドライエッティング時間を長くして、凸部42aの高さHを1μmとした基板31を得ることができ、高さHが1μmである反射電極38を有する基板31を基板59とする。

【0042】図1に示される他方の基板45に形成される電極47は、たとえばITOから成り、厚さは1000Åである。配向膜44、48は、ポリイミドなどを塗布後、焼成することによって形成されている。基板31、45間には、たとえば7μmのスペーサを混入した図示しない接着性シール剤をスクリーン印刷することによって液晶49を封入する空間が形成され、前記空間を真空脱気することによって、液晶49が注入される。液晶49としては、たとえば黒色色素を混入したゲストホスト液晶(メルク社製、商品名:ZLI2327)に、光学活性物質(メルク社製、商品名:S811)を4.5%混入したものを使っている。

【0043】図6は、反射電極38を有する基板52、59の反射特性の測定法を示す断面図である。反射電極38を有する基板52、59上に紫外線硬化接着樹脂53を介してガラス基板54を密着し、測定用装置55を形成する。反射型液晶表示装置30において、基板45と液晶49との屈折率のいずれも約1.5であるので、紫外線硬化接着樹脂53および基板54の屈折率は約1.5のものを用いている。基板54の上部に、光の強度を測定するホトマルチメータ56が配置されている。ホトマルチメータ56は、反射電極38に基板31に対して入射角θで入射する入射光57のうち、基板31の法線方向に反射する散乱光58を検出するように、基板31の法線方向に固定されている。

【0044】測定用装置55に入射される入射光57の入射角θを変化させて反射電極38による散乱光58を測定することによって、反射電極38の反射特性が得られる。この測定結果は、反射型液晶表示装置30内の反射電極38と液晶49層などとの境界における反射特性と同様の結果が得られることが確認されている。

【0045】図7は、本実施の形態の反射電極38を有する基板52、59の反射特性を示すグラフである。基板52の反射特性は曲線60で示され、基板59の反射特性は曲線61で示される。図7において、入射角θをもって入射する光の反射強度は、θ=0°の線に対する角θの方向に、原点0からの距離として表されている。また、図7に破線で示す曲線62は、標準白色板(酸化マグネシウム)について測定した反射特性を示す。基板52の反射特性を示す曲線60は、入射角は小さい場合には基板の法線方向の反射率が大きく、入射角が大きい場合には法線方向の反射率が小さいという指向性を持っている。それに対して、基板59の反射特性を示す曲線61は、標準反射板の反射特性を示す曲線62と同様の

反射特性を示す曲線61を有していることが判る。

【0046】このように、ドライエッチング時間と制御することによって反射特性60、61を制御することができる。また、マスク51の遮光領域51aの占める割合を変化させることによって、正反射成分の大きさを制御することができる。

【0047】反射型液晶表示装置30上にホトマスクメータ56を配置して、反射率を測定した。反射率は、入射光57の入射角θが30°のときの標準白色板における法線方向への拡散光58の強度に対する、反射型液晶表示装置30の法線方向への拡散光58の強度の比率を求ることによって得られる。電圧を印加した場合、入射角θ=30°の入射光に対する反射型液晶表示装置30の反射率は、約20%とかなり明るく、コントラスト比は5であった。

【0048】図8は、本発明の一実施形態である反射型液晶表示装置30の白色光源光に対する反射光の色をCIE色度図に示したグラフである。点W1は白色光源光を示し、点W2は反射型液晶表示装置30によって表示される白色を示し、点Gは反射型液晶表示装置30によって表示される緑色を示し、点Mは反射型液晶表示装置30によって表示されるマゼンタを示している。反射型液晶表示装置30の白色を示す点W2は、白色光源光を示す点W1に近いことが判る。

【0049】本実施の形態の反射型液晶表示装置30では、反射電極38を形成した面が液晶49側に位置しているため、視差がなくなり、良好な表示画面が得られる。また、本実施の形態では、凹凸を有する反射電極38が液晶49層側、すなわち液晶49層にはほぼ隣接する位置に配置されている構成となるため、凸部42aの高さHは、液晶層厚よりも小さく、凸部の傾斜角度は液晶の配向を乱さない程度に穏やかにすることが望ましい。

【0050】さらに、本実施の形態では、有機絶縁膜42のバーニングをドライエッチング法によって行ったが、有機絶縁膜42がポリイミド樹脂の場合には、アルカリ溶液によるウェットエッチング法によって行ってもよい。また、有機絶縁膜42としてポリイミド樹脂を用いたが、アクリル樹脂などの他の有機材料を用いてもよい。さらに本実施の形態では、基板31、45として、ガラスなどから成る透明な材料を用いたが、シリコン基板のような不透明な材料でも同様な効果が発揮され、この場合には回路を基板上に集積できる利点がある。

【0051】なお、前記実施の形態においては、表示モードとして相転移型ゲスト・ホストモードを取上げたけれども、これに限定されることはなく、たとえば2層式ゲスト・ホストのような他の光吸収モード、高分子分散型液晶表示装置のような光散乱型表示モード、強誘電性液晶表示装置で使用される複屈折表示モードなどでも同様の効果が得られる。また本実施の形態では、スイッチング素子としてTFT40を用いた場合について説明し

たけれども、たとえばMIM(Metal-Insulator-Metal)素子、ダイオード、バリスタなどを用いたアクティブマトリクス基板にも適用することができる。

【0052】図9は、本発明の実施の形態を示す基板31の複数の反射電極38を示した平面図である。反射電極38上には、有機絶縁膜40に形成される凸部42aを介して凸部38aが不規則に形成されている。しかしながら、反射電極38の凸部38aの不規則さは、どの反射電極38をとっても同様である。これは、有機絶縁膜42上に凸部42aを形成する際に用いられるホトマスク51の各反射電極38に対応する領域に、同じ配列パターンで遮光領域51aを形成しているためである。

【0053】凸部42aを形成するためのホトマスク51の各反射電極38に対応する領域に、それぞれ異なる配列パターンの遮光領域51aを設計することもできるけれども、このような方法を採ると、配列パターンの形成に必要とされるデータ量が増大し、ホトマスク51の作成が困難となる。しかしながら、本実施の形態によれば、各反射電極38に対応する領域のホトマスク51上には、それぞれ同じ配列パターンで遮光領域51aが形成されるため、1つの反射電極38に対応する配列パターンを形成するだけによく、ホトマスク51の作成が容易となる。

【0054】また、図9に示される凸部42aは、2種類の円形の遮光領域が不規則に配列されているホトマスクを用いて形成されている。凸部38aの大きさは、たとえば断面形状の最大直径を5μmと10μmとし、高さは0.6μmとし、それらが1つの反射電極38に対応する領域でのみランダムに形成し、残りの絵素はその配列パターンを繰返している。たとえば、絵素の大きさは、300μm×300μm、絵素数320×240、対角サイズ5インチであるようなモノクロ反射型液晶表示装置を作成した。

【0055】なお、反射型液晶表示装置30の構成、凸部42aの作成方法、表示モードなどは前述したとおりである。全面点灯させたときの表示は、隣の絵素との干渉による色は見えず、良好な白色が得られた。

【0056】反射電極38の数が多くなり、反射電極39のピッチが小さくなったときに、特に隣の反射電極38が形成する絵素との干渉色が問題となる場合には、2種類以上の配列パターンを組合せてホトマスク51を形成すればよい。

【0057】以上のように、本実施の形態によれば、反射電極38部分のみに凹凸を形成するため、ソースバス配線39と反射電極38との絶縁不良が生じず、また反射電極38周縁部の有機絶縁膜42上は凹凸がなく平坦であるためバーニング不良は生じず、反射型液晶表示装置30の表示品位が向上する。また、反射電極38部分に形成される凸部42aは不規則に配置され、また先

細状にかつ先端部は球面状に形成され、1種類あるいは大きさの異なる2種類以上の形状から成るため、反射型液晶表示装置30の法線方向への拡散光の強度が向上する。

【0058】また、本実施の形態によれば、前記凸部42aの配列パターンが各反射電極38において同一もしくは2種類以上の配列パターンの組合せであるため、容易に凸部の形成を行うことができる。

【0059】図10は、本発明の実施の形態である反射型液晶表示装置130の断面図であり、図11は、図10に示される基板131の平面図である。ガラスなどから成る絶縁性の基板131上に、クロム、タンタルなどから成る複数のゲートバス配線132が互いに平行に設けられ、ゲートバス配線132からはゲート電極133が分岐している。ゲートバス配線130には、走査線として機能している。

【0060】ゲート電極133を覆って基板131上の全面に、窒化シリコン(SiNx)、酸化シリコン(SiOx)などから成るゲート絶縁膜134が形成されている。ゲート電極133の上方のゲート絶縁膜134上には、非晶質シリコン(以下、「a-Si」と記す)、多結晶シリコン、CdSeなどから成る半導体層135が形成されている。半導体層135の両端部には、a-Siなどから成るコンタクト電極141が形成されている。一方のコンタクト電極141上には、チタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るソース電極136が重疊形成され、他方のコンタクト電極141上には、ソース電極136と同様にチタン、モリブデン、アルミニウムなどから成るドレイン電極137が重疊形成されている。

【0061】図11に示すように、ソース電極136には、ゲートバス配線132と前述のゲート絶縁膜134を挟んで交差するソースバス配線139が接続されている。ソースバス配線139は、信号線として機能している。ソースバス配線139も、ソース電極136と同様の金属で形成されている。ゲート電極133、ゲート絶縁膜134、半導体層135、ソース電極136およびドレイン電極137は、薄膜トランジスタ(以下、「TFT」と記す)140を構成し、該TFT140は、スイッチング素子の機能を有する。

【0062】反射電極138が形成される領域には、複数の凸部142aが不規則に形成されている。ゲートバス配線132、ソースバス配線139、TFT140および凸部142aを覆って、基板131上全面に有機絶縁膜142が形成されている。有機絶縁膜142には、凸部142aに応じた凸部142bが生じる。ドレイン電極137部分には、コンタクトホール143が形成されている。液晶表示装置130を作成する際の液晶層厚のバラツキを小さくするため、凸部142bの高さH1は液晶層の厚さより小さい10μm以下が好ましい。一

般に、液晶層の厚さは10μm以下であるためである。また、凸部142aのピッチは、100μm以下が好ましい。凸部142aが形成されている領域上の有機絶縁膜142上にアルミニウム、銀などから成る反射電極138が形成され、反射電極138はコンタクトホール143においてドレイン電極137と接続される。さらに、その上に配向膜144が形成される。

【0063】反射電極138は、図11に示されるように、ゲートバス配線132の一部およびソースバス配線139の一部に有機絶縁膜142を介して重疊されるように形成されている。このため、反射電極138の面積を大きくすることができ、表示画面の開口率が大きくなり、明るい表示が可能となる。反射電極138のパターニング不良をなくすためには、反射電極138の周縁部には、凸部142aを形成しない構成とすればよい。また、反射電極138とゲートバス配線132およびソースバス配線139との絶縁不良が生じるときには、重疊する部分には凸部142aを形成しない構成とすればよい。

【0064】基板145上には、カラーフィルタ146が形成される。カラーフィルタ146は、基板131の反射電極138に対向する領域には、マゼンタまたは緑色のフィルタ146aが形成され、反射電極138に対向しない領域には、黒色のフィルタ146bが形成される。カラーフィルタ146上の全面には、ITOなどから成る透明電極147、さらにその上に配向膜148が形成される。

【0065】両基板131、145は、反射電極138とフィルタ146aとが一致するように間隔をあけて対向して貼合わせられ、基板間に液晶149が注入されて反射型液晶表示装置130が完成する。

【0066】図12は、図11および図12に示される凸部を有する反射電極138を基板131上に形成する形成方法を説明する工程図であり、図13は、図12に示す形成方法を説明する断面図であり、図14は、図12の工程a5で用いられるマスク151の平面図である。図13(1)は、図12の工程a4を示し、図13(2)は、図12の工程a5を示し、図13(3)は、図12の工程a6を示し、図13(4)は、図12の工程a8を示し、図13(5)は、図12の工程a9を示している。

【0067】工程a1では、ガラスなどから成る絶縁性の基板131上にスパッタリング法によって3000Åの厚さのタンタル金属層を形成し、この金属層をホトリソグラフ法およびエッティングによってパターニングを行い、ゲートバス配線132およびゲート電極133を形成する。工程a2では、プラズマCVD法によって4000Åの厚さの窒化シリコンから成るゲート絶縁膜134を形成する。

【0068】工程a3では、半導体層135となる厚さ

1000Åのa-Si層と、コンタクト層141となる厚さ400Åのn⁺型a-Si層とをこの順で連続的に形成する。形成されたn⁺型a-Si層およびa-Si層のバーニングを行い、半導体層135およびコンタクト層141を形成する。工程a4では、基板131の全面に厚さ2000Åのモリブデン金属層をスパッタ法によって形成し、このモリブデン金属層のバーニングを行って、ソース電極136、ドレイン電極137およびソースバス配線139を形成し、TFT140が完成する。図13(1)は、工程a4までの処理終了後のTFT140が形成された基板131の断面図である。

【0069】工程a5では、TFT140を形成した基板131上全面にホトレジスト(商品名:OFPTR-800)を1200Åの厚さに塗布し、図14に示されるマスク151を用いて、図13(2)に示されるように、凸部142aを形成する。マスク151には、反射電極138の形成領域に図14に示されるように、斜線で示す円形の遮光領域151a、151bが不規則に形成されている。遮光領域151aの直径D1は、遮光領域151bの直径D2よりも大きく形成されている。たとえば、直径D1は10μmであり、直径D2は5μmである。直径D1、D2は、それぞれ20μm以下が好ましい。本実施の形態では、2種類の遮光領域151a、151bを有するマスク151を用いたけれども、マスク151はこれには限定されない。遮光領域は1種類の円形でもよく、また3種類以上の円形でもよい。その後、熱処理を行い、図13(2)に示されるように、凸部142aを角がとれた形状に形成する。

【0070】工程a6では、基板131上全面にポリイミド樹脂を1μmの厚さに塗布し、図13(3)に示されるように、有機絶縁膜142を形成する。工程a7では、ホトリソグラフ法およびドライエッティング法を用いて有機絶縁膜142にコンタクトホール143を形成する。

【0071】工程a8では、凸部142bを有する有機絶縁膜142上全面に図13(4)に示されるように、アルミニウムから成る金属薄膜を形成し、工程a9では図13(5)に示されるように凸部142b上に反射電極138をバーニングする。反射電極138は、有機絶縁膜142に形成されたコンタクトホール143を介してTFT140のドレイン電極137と接続されている。反射電極138のバーニング時に、有機絶縁膜142の下のホトレジストから成る凸部142aは、露光、現像、アルミニウムのエッティング、レジストの剥離の工程を通して、何の変化も見られないことを確認している。

【0072】凸部142aの形状は、マスク151の形状、凸部142aとなるホトレジストの厚さによって制御することができることが確認されている。また、凸部142aの角は、凸部142aの形成後、熱処理をする

ことによって容易にとることができる。

【0073】図10に示される他方の基板145に形成される電極147は、たとえばITOから成り、厚さは1000Åである。電極138、147上の配向膜144、148は、ポリイミドなどを塗布後、焼成することによって形成されている。基板131、145間には、たとえば7μmのスペーサを混入した図示しない接着性シール剤をスクリーン印刷することによって、液晶149を封入する空間が形成され、前記空間を真空脱気することによって液晶149が注入される。液晶149としては、たとえば黒色色素を混入したゲストホスト液晶(メルク社製、商品名:ZL12327)に、光学活性物質(メルク社製、商品名:S811)を4.5%混入したものを用いる。

【0074】図15は、本発明の反射型液晶表示装置130の反射特性の測定に用いられる反射板170の製造工程を説明する工程図であり、図16は、図15の各工程を説明する断面図である。工程b1では、図16(1)に示すように、厚さ1.1mmのガラス(商品名、7059:コーニング社製)171の一方表面に、レジスト材料として、たとえばOFTTR-800(東京応化社製)を好ましくは500rpm~3000rpmでスピンドルによって塗布する。本実施の形態では、3000rpmで30秒間塗布し、レジスト172を1.2μm成膜した。

【0075】工程b2では、レジスト172を100℃で30分間プリベークし、工程b3では、図16(2)に示すように、レジスト172上に円形の遮光領域151a、151bを有するホトマスク151を配置して露光を行い、工程b4では、図16(3)に示すように、レジスト172を現像し、基板171表面に不規則な略円柱形の凸部174を形成した。現像液として、2.38%のNMD-3(東京応化社製)を用いた。

【0076】工程b5では、ガラス基板171上の凸部174を好ましくは120℃~250℃で熱処理すると、図16(4)に示されるように角はとれて球面状の滑らかな凸部174が形成される。本実施の形態では、180℃で30分間熱処理を行った。工程b6では、図16(5)に示すように凸部174を形成した基板171上有機絶縁膜174aを形成した。有機絶縁膜174aとしては、ポリイミド樹脂を好ましくは920rpm~3500rpmで20秒間スピンドルによって塗布する。本実施の形態では、2200rpmで20秒間塗布し、1μmの厚さの有機絶縁膜174aを成膜した。有機絶縁膜174aには、凸部174に応じた凸部が生じるが、凸部174よりは滑らかである。

【0077】工程b7では、図16(6)に示すように有機絶縁膜174a上に金属薄膜175を形成した。金属薄膜175としては、アルミニウム、ニッケル、クロム、銀、銅などが挙げることができる。金属薄膜175

の厚さは、0.01 μm ～1.0 μm 程度が適している。本実施の形態では、アルミニウムを真空蒸着することによって金属薄膜175を形成した。金属薄膜175は、凸部174に沿って形成された有機絶縁膜174a上に形成されているため、凸部174に応じた不規則な円形の凸部175aを有している。以上によって反射板170を得た。

【0078】図17は、反射板170の反射特性の測定法を説明する側面図である。通常、液晶表示装置130に用いられる基板131、145および液晶149層の屈折率は、それぞれ約1.5である。反射板170の表面と、液晶149層とが接する構成を想定し、本実施の形態では屈折率1.5の紫外線硬化樹脂177を用いてガラス基板176を反射板170に密着させて、反射板170の反射特性を測定した。この測定結果は、反射板175の表面と液晶149層の境界における反射特性と同様の結果を与えることを確認している。

【0079】図17に示すように、反射特性の測定は、反射板170に入射する入射光179の散乱光180をホトマルチメータ178で検出することによって行われる。反射板170には、その法線に対し角度 θ をもって入射光179が入射する。ホトマルチメータ178は、金属薄膜175上の入射光179が照射される点を通る反射板170の法線方向に固定されている。入射光179の入射角度 θ を代えて入射光179の金属薄膜175による散乱光180の強度を測定することによって反射特性が得られた。

【0080】図18は、入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。入射角度 θ である入射光179の反射強度は、 $\theta=0^\circ$ の線に対する角度 θ の方向に、原点0からの距離として表されている。 $\theta=70^\circ$ の反射強度をP1、 $\theta=60^\circ$ の反射強度をP2、 $\theta=40^\circ$ の反射強度をP3、 $\theta=30^\circ$ の反射強度をP4、 $\theta=-30^\circ$ の反射強度をP5、 $\theta=-40^\circ$ の反射強度をP6、 $\theta=-60^\circ$ の反射強度をP7、 $\theta=-70^\circ$ の反射強度をP8で示している。

【0081】図18では、酸化マグネシウムの標準白色板の反射特性曲線を破線81で示している。 $\theta=30^\circ$ の反射強度P4は、 $\theta=30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P10よりも優れており、 $\theta=-30^\circ$ の反射強度もまた $\theta=-30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P11よりも優れていることが判る。

【0082】以上のように、本実施の形態によれば、形状の制御が容易であり、再現性を有するホトレジストから成る凸部142a上に凸部142aに沿って形成された凸部142bを有する有機絶縁膜142上に、凸部142bに沿った反射電極138を形成する。凸部142aの形状を制御することによって、良好な反射特性を有する反射電極138が得られ、反射型液晶表示装置130の表示品位が向上する。

【0083】前述のホトマスク151は、図19に示すようなものを用いるのが好ましい。図19(1)では、遮光領域151a、151bの総面積がマスク151の総面積の約47%であり、図19(2)では遮光領域151a、151bの総面積がマスク151の総面積の41%である。

【0084】図20は、遮光領域151a、151bが総面積の40%以上を占めるマスク51、151を用いて形成された反射薄膜75、175における入射角度 θ と反射強度との関係を示すグラフである。入射角度 θ である入射光78、178の反射強度は、 $\theta=0^\circ$ の線に対する角度 θ の方向に、原点0からの距離として表されている。 $\theta=70^\circ$ の反射強度をP21、 $\theta=60^\circ$ の反射強度をP22、 $\theta=40^\circ$ の反射強度をP23、 $\theta=30^\circ$ の反射強度をP24、 $\theta=25^\circ$ の反射強度をP25、 $\theta=-25^\circ$ の反射強度をP26、 $\theta=-30^\circ$ の反射強度をP27、 $\theta=-40^\circ$ の反射強度をP28、 $\theta=-60^\circ$ の反射強度をP29、 $\theta=-70^\circ$ の反射強度をP30で示している。

【0085】図20では、また酸化マグネシウムの標準白色板の反射特性曲線を破線181で示している。 $\theta=30^\circ$ の反射強度P24は、 $\theta=30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P34よりも優れており、 $\theta=-30^\circ$ の反射強度P27もまた $\theta=-30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P37よりも優れていることが判る。

【0086】これに対し、遮光領域151a、151bが総面積の40%未満、たとえば35%のホトマスク151を用いて同様の方法で反射板の反射特性を図21に示す。 $\theta=30^\circ$ の反射強度P54は、 $\theta=30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P44よりも劣っており、 $\theta=-30^\circ$ の反射強度P57もまた $\theta=-30^\circ$ の酸化マグネシウムの反射強度P47よりも劣っていることが判る。これは、凸部が40%未満であると、正反射成分が非常に多く、散乱が少ないと視野が狭められていたと考えられる。

【0087】図22は、遮光領域151a、151bのマスクの総面積に占める割合を変化させたホトマスク151を用いて作成した反射板の $\theta=30^\circ$ での反射率を示す。図22から凸部の割合を40%以上とすることによって高い反射率の反射板が得られることが判る。この他に、ホトレジストの種類や、膜厚、熱処理温度を選択することによって、凸部の傾斜角度を自由に制御することができ、これによって反射特性を制御できる。また、有機絶縁膜の種類や膜厚によっても反射特性を制御できる。

【0088】本実施の形態の反射型液晶表示装置130では、反射電極138を形成した面が液晶149側に位置しているため視差がなくなり、良好な表示画面が得られる。また本実施の形態では、凹凸を有する反射電極138が液晶149層側、すなわち液晶149層にほぼ隣

接する位置に配置されている構成となるため、凸部142bの高さH1は、液晶層厚よりも小さく、凸部の傾斜角度は液晶分子の配向を乱さない程度に穏やかにすることができる。また本実施の形態では、反射電極138形成領域のみに凸部142aを形成したけれども、基板131全面に凸部142aを形成してもよい。また、反射電極138を透明電極として、別に反射板を設けてもよく、この場合にも同様に、不規則な複数の凸部上に形成された有機絶縁膜上に反射板が形成される。また、スイッチング素子としてTFT140を用いるアクティブマトリクス駆動方式の反射型液晶表示装置130について説明したけれども、これに限られるものではなく、単純マトリクス駆動方式などの反射型液晶表示装置でも同様の効果が得られる。

【0089】さらに、本実施の形態では有機絶縁膜142のパターニングをドライエッチング法によって行ったが、有機絶縁膜142がポリイミド樹脂の場合には、アルカリ溶液によるウエットエッチング法によって行ってもよい。また、有機絶縁膜142としてポリイミド樹脂を用いたが、アクリル樹脂などの他の有機材料を用いてもよい。さらに本実施の形態では、基板131として、ガラスなどから成る透明な材料を用いたが、シリコン基板のような不透明な材料でも同様な効果が発揮され、この場合には回路を基板上に集積できる利点がある。

【0090】なお、前記実施の形態においては、表示モードとして相転移型ゲスト・ホストモードをとりあげたけれども、これに限定されることはなく、たとえば2層式ゲスト・ホストのような他の光吸収モード、高分子分散型液晶表示装置のような光散乱型表示モード、強誘電性液晶表示装置で使用される複屈折表示モードなどでも同様の効果が得られる。また本実施の形態では、スイッチング素子としてTFTを用いた場合について説明したが、たとえばMIM(Metal-Insulator-Metal)素子、ダイオード、バリスタなどを用いたアクティブマトリクス基板に適用することができる。

【0091】図23は、本発明の実施の形態を説明するための平面図である。本実施の形態の特徴は、前述の図2に示すように凹凸を形成した反射型アクティブマトリクス基板31上に、電気絶縁性材料から成る黒色遮光層71を形成したことである。黒色遮光層71は、図23において斜線を付した領域、すなわち、反射電極38以外の領域とTFT40を構成する半導体層35の形成領域とに形成される。なお、前述の図10および図11に示される反射型アクティブマトリクス基板131上に黒色遮光層71を形成してもよい。

【0092】図24は、黒色遮光層71の形成方法を説明するための断面図である。ここでは、図6に示されるアクティブマトリクス基板31を例にとり説明するが、アクティブマトリクス基板131の場合も同様である。

【0093】先ず、基板31の全面に、図24(1)に

示すように、可視光を吸収するように赤色、青色、緑色の顔料をそれぞれ分散させた感光性アクリル樹脂、たとえば富士ハント社製、商品名：カラー モザイクCR、CG、CBを3種類混ぜ合わせて黒色を呈した樹脂71をスピナ用いて塗布する。

【0094】続いて、図24(2)に示すように、所定のマスク72を用いて露光し、現像した後に、反射電極38以外の領域と、TFT41を構成する半導体層35の形成領域と完全に覆うように、不要な部分をエッチングによって取除いて、図24(3)に示すように、黒色遮光層71を形成した。その後、200℃で1時間加熱し、黒色遮光層71を硬化させた。

【0095】以上のように、本実施の形態によれば、黒色遮光層71を形成して反射電極38以外の部分の反射光(散乱光)を遮るようにしたので、表示に不必要的光の漏れを防止することができ、コントラストの優れた反射型液晶表示装置を実現することができる。また、対向する基板45上に黒色遮光層71を形成する場合に比べて、基板貼合わせ時のマージンを大きくとることができ、基板貼合わせのずれによる開口率の低下を少なくした明るい表示を実現することができる。

【0096】本実施の形態では、黒色遮光層71の材料として、顔料を分散させたアクリル樹脂を用いたが、カーボンを分散させたアクリル樹脂、たとえば富士ハント社製、商品名：カラー モザイクBKのような有機材料や、アモルファスシリコングルマニウム(a-SiGe；H)、あるいは銀の無電界メッキなどの無機物も適用可能である。また、黒色遮光層71の厚みは、用いる材料の吸収係数を考慮して、好ましくは透過率を少なくとも5%以下に、より好ましくは1%以下になるように設定する必要がある。

【0097】

【発明の効果】以上のように、本発明の反射型液晶表示装置によれば、前記凹凸部の配列パターンが同一である反射電極を有しており、そのため、反射電極毎に異なる配列パターンで形成する必要はなく、反射電極が形成される全領域に容易に前記凹凸部を形成することが可能となる。つまり、反射電極に対応する領域のホトマスク上には、それぞれ同じ配列パターンで遮光領域が形成されるため、一つの反射電極に対応する配列パターンを形成するだけによく、ホトマスクの作成が容易に可能となっている。

【0098】また本発明の反射型液晶表示装置の製造方法によれば、前記遮光手段は、前記略円形のパターンが形成された遮光領域の総面積を反射電極の総面積の40%以上としているため、高い反射率を得ることが可能となる。つまり、遮光手段の遮光領域の総面積を反射電極の総面積の40%以上とすることにより、正反射成分が多くならず、散乱が多くなるために、観察者の視角範囲において高い反射率を得ることが可能となっている。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態である反射型液晶表示装置30の断面図である。

【図2】図1に示される基板31の平面図である。

【図3】図1および図2に示される基板31上に凹凸を有する反射電極38を形成する形成方法を説明する工程図である。

【図4】図3に示す形成方法を説明する断面図である。

【図5】図3の工程s7で用いるマスク51の平面図である。

【図6】反射電極38を有する基板52の反射特性の測定法を示す断面図である。

【図7】本発明の反射型アクティブマトリクス基板52、59の反射特性60、61を示すグラフである。

【図8】本発明の一実施形態である反射型液晶表示装置30の白色光源光に対する反射光の色をCIE色度図に示したグラフである。

【図9】本発明の一実施形態を示す基板31の平面図である。

【図10】本発明の一実施形態である反射型液晶表示装置130の断面図である。

【図11】図10に示される基板131の平面図である。

【図12】図10および図11に示される凸部を有する反射電極138を形成する形成方法を説明する工程図である。

【図13】図12に示す形成方法を説明する断面図である。

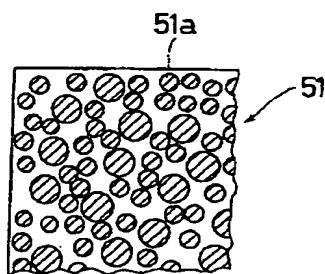
【図14】図12の工程a5で用いるマスク151の平面図である。

【図15】本発明の反射型液晶表示装置130の反射特性の測定に用いられる反射板170の製造工程を説明する工程図である。

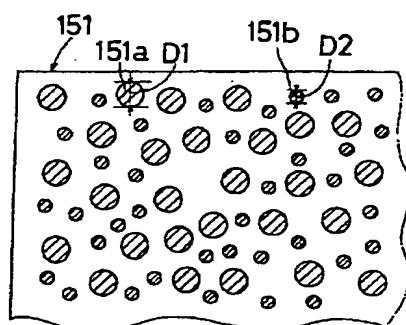
【図16】図15の工程を説明する断面図である。

【図17】反射板170の反射特性の測定法を説明する斜視図である。

【図5】



【図14】



【図18】入射角度θと反射強度との関係を示すグラフである。

【図19】マスク51を示す平面図である。

【図20】遮光領域51a、151aの総面積がマスクの総面積の40%以上であるマスク51を用いて形成された反射薄膜75における入射角度θと反射強度との関係を示すグラフである。

【図21】遮光領域151aの総面積が全体の35%を占めるマスク151を用いて形成された反射薄膜75における入射角度θと反射強度との関係を示すグラフである。

【図22】遮光領域の割合と反射率との関係を示すグラフである。

【図23】本発明の一実施形態を説明するための平面図である。

【図24】黒色遮光層71の形成方法を説明するための断面図である。

【図25】アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ1を有する基板2の平面図である。

【図26】図25に示される切断面線X26-X26から見た断面図である。

【図27】アクティブマトリクス方式に用いられるスイッチング素子である薄膜トランジスタ11を有する基板12の平面図である。

【図28】図27に示される切断面線X28-X28から見た断面図である。

【符号の説明】

30、130 反射型液晶表示装置

31、45、131、145 基板

38、138 反射電極

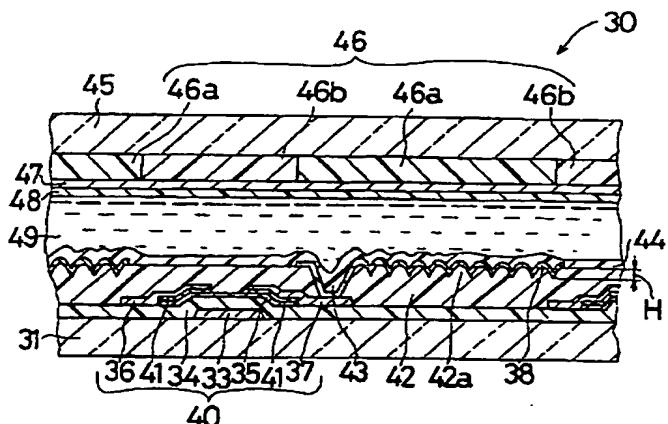
42、142 有機絶縁膜

42a、142a 凸部

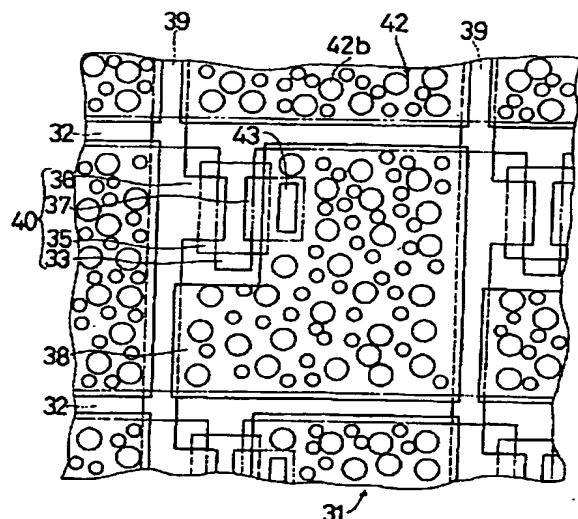
49、149 液晶

51、151 ホトマスク

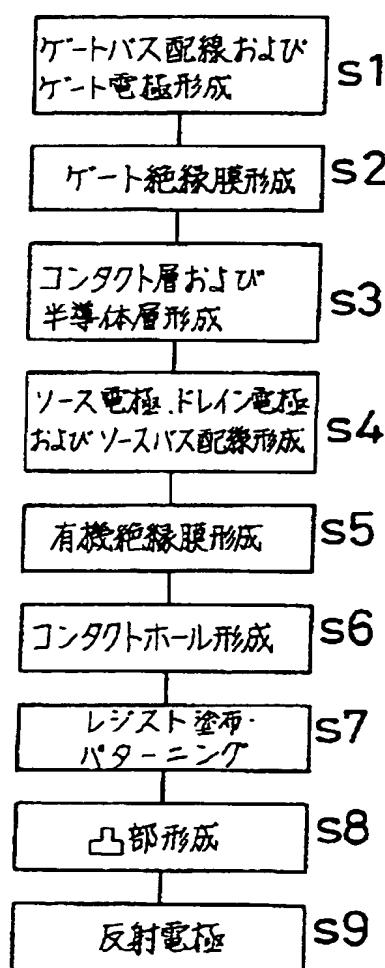
【図1】



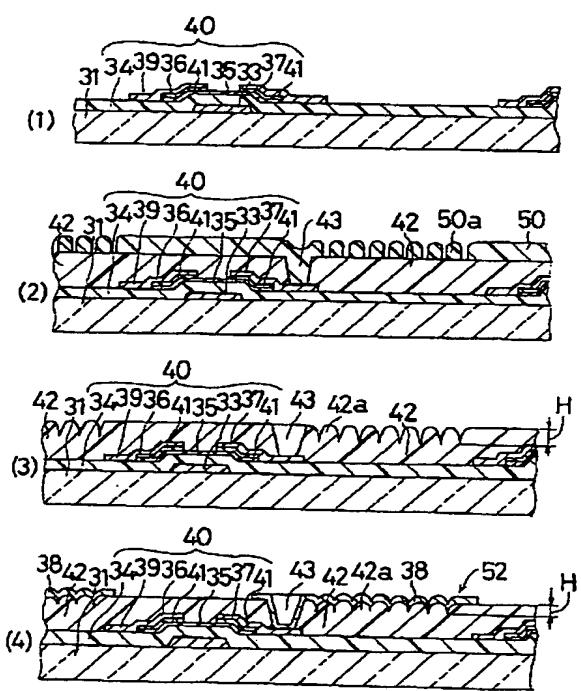
【図2】



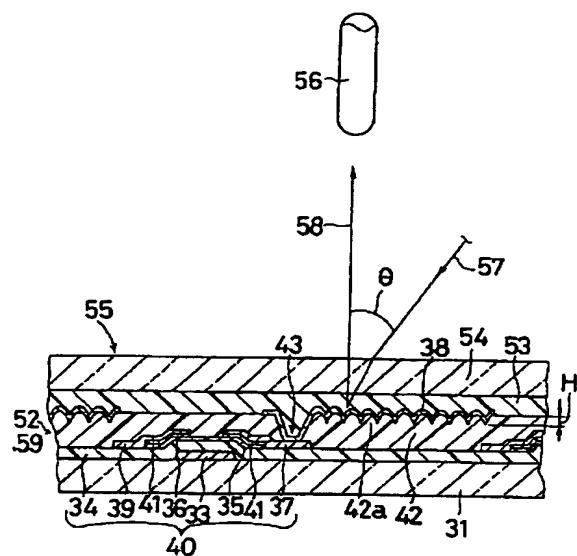
【図3】



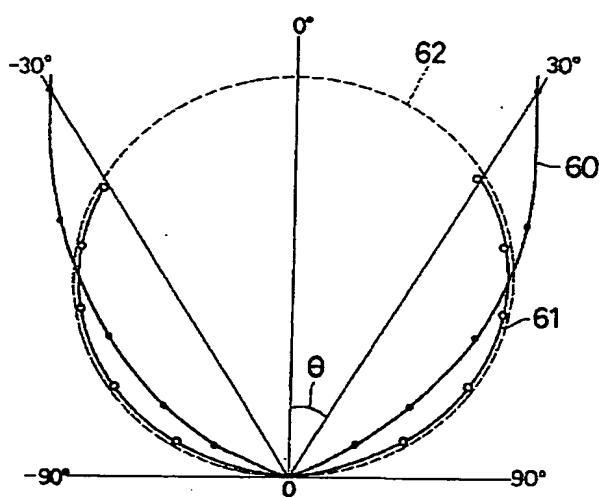
【図4】



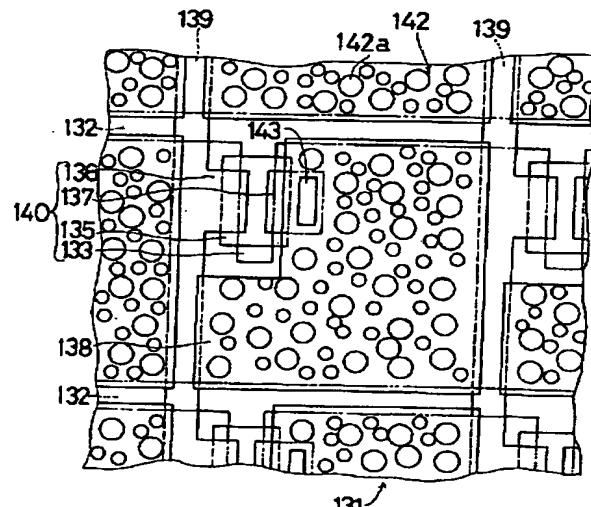
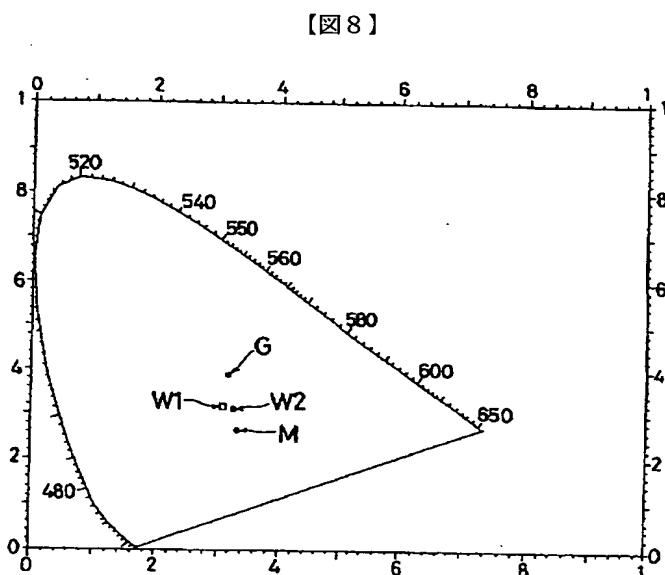
【図6】



【図7】

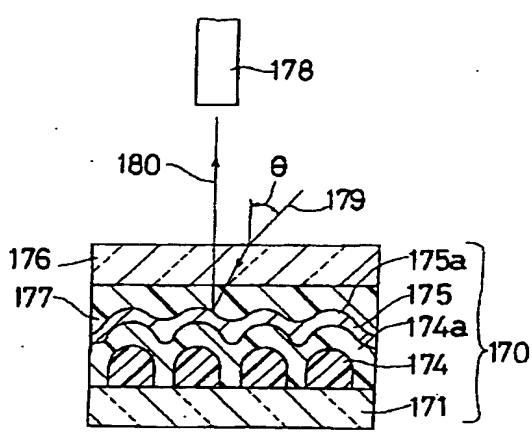
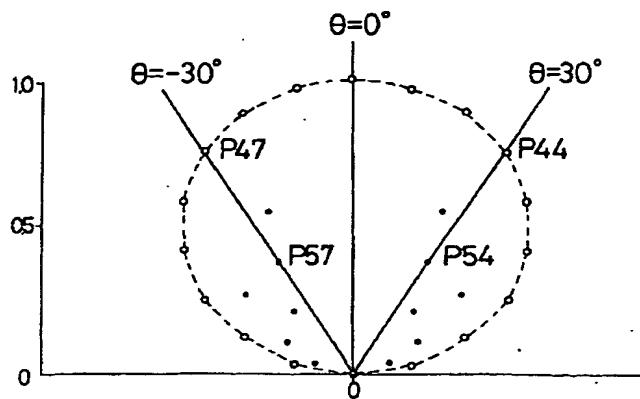


【図11】

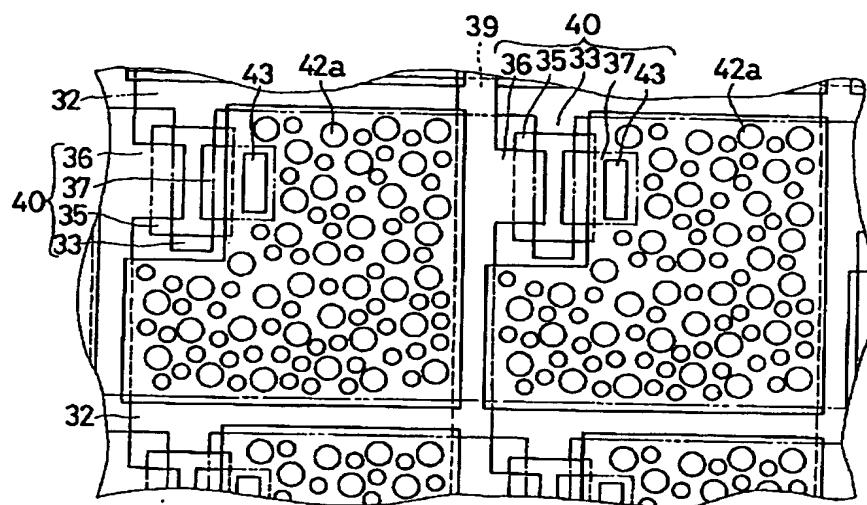


【図17】

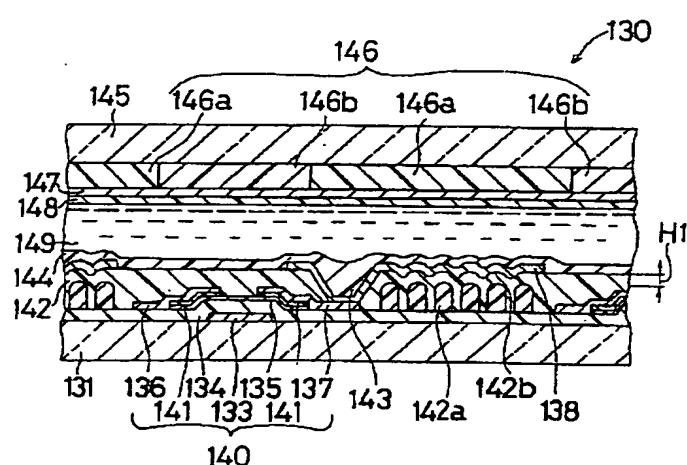
【図21】



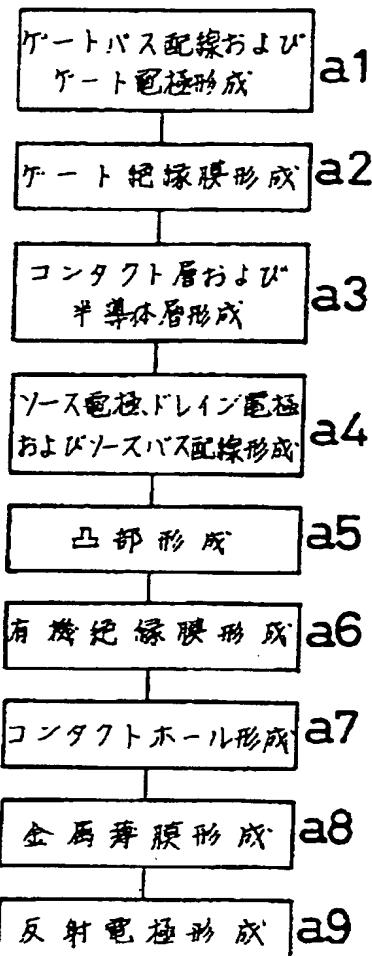
【図9】



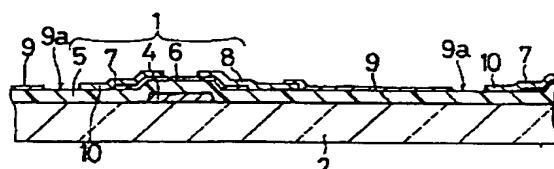
【図10】



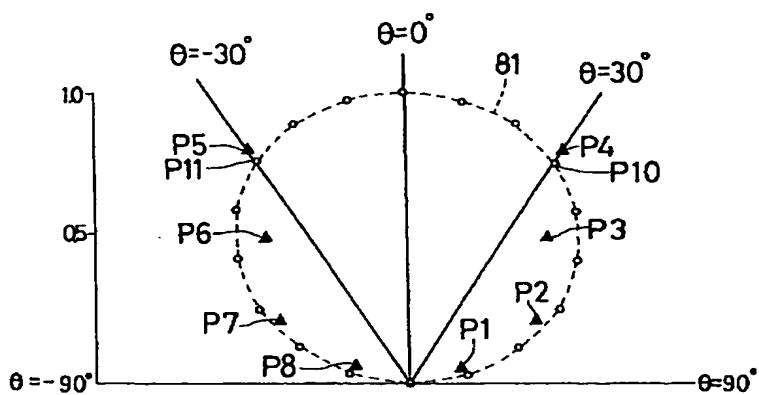
【図12】



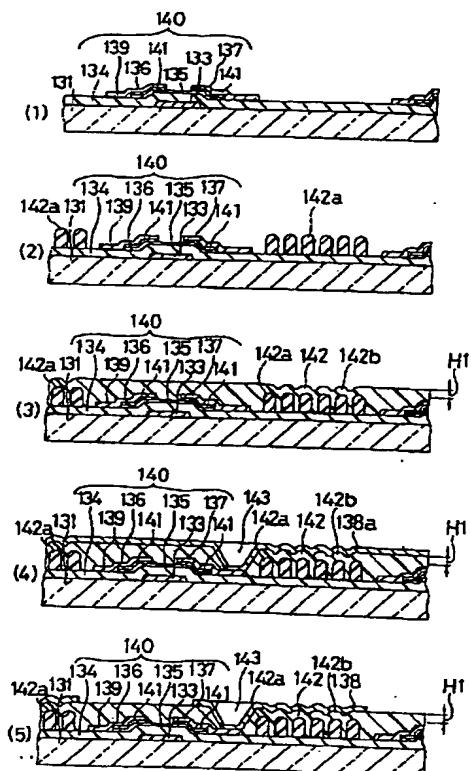
【図26】



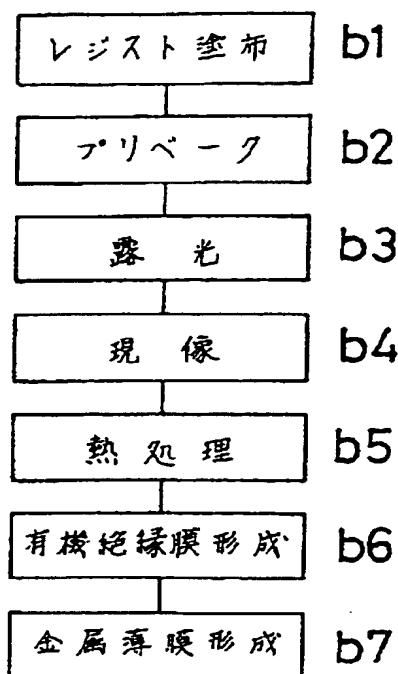
【図18】



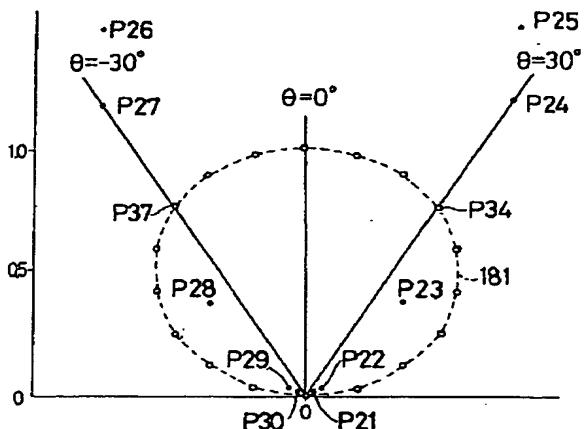
【図13】



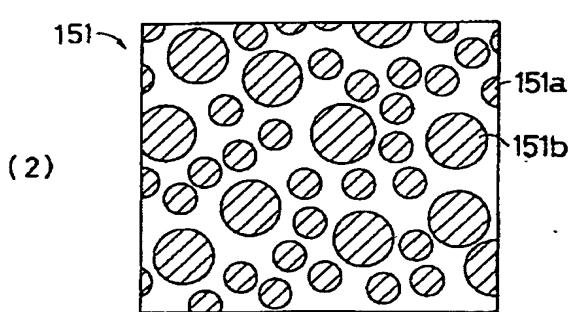
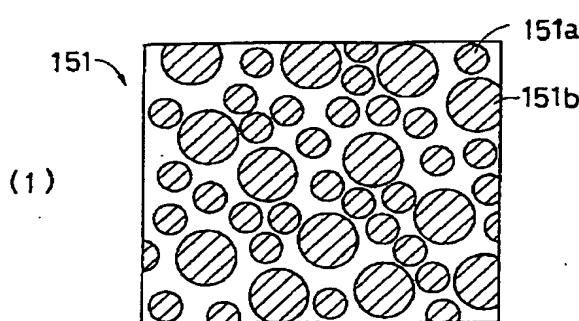
【図15】



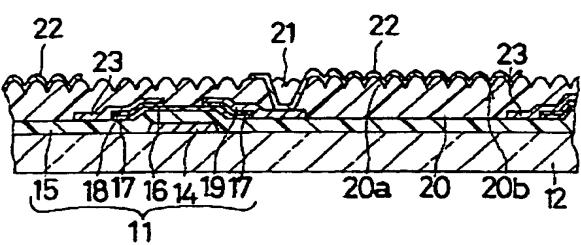
【図20】



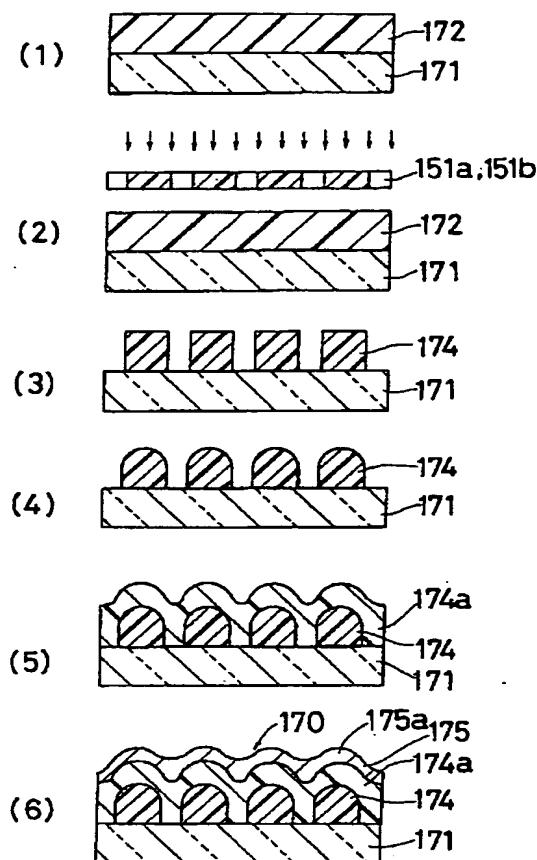
【図19】



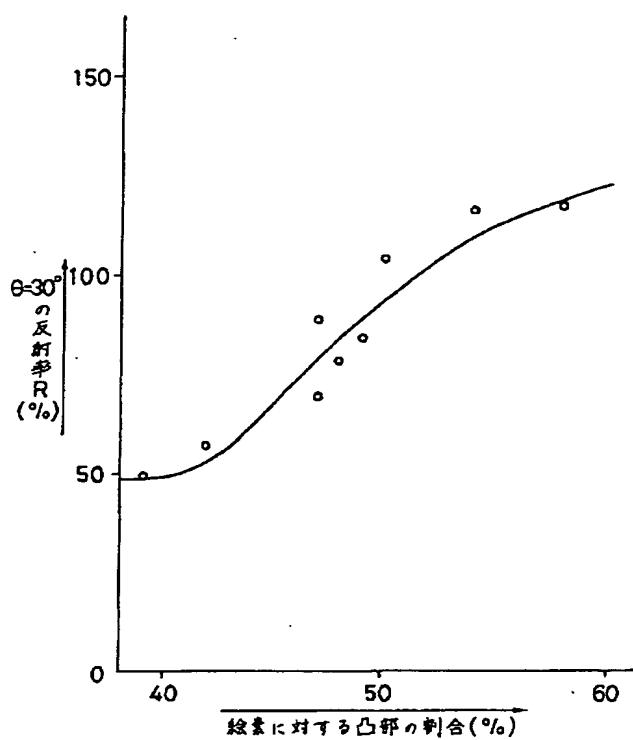
【図28】



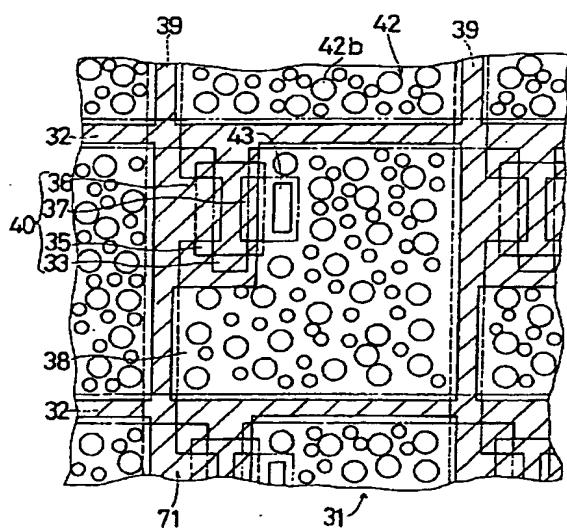
【図16】



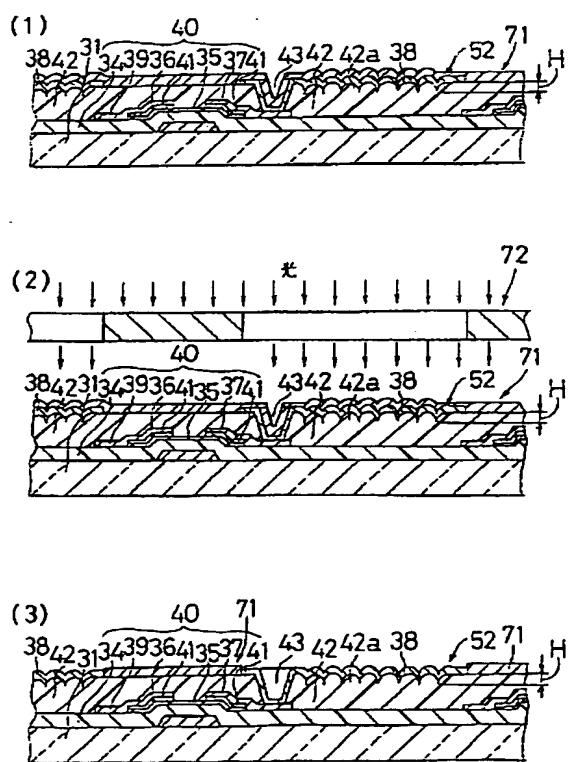
【図22】



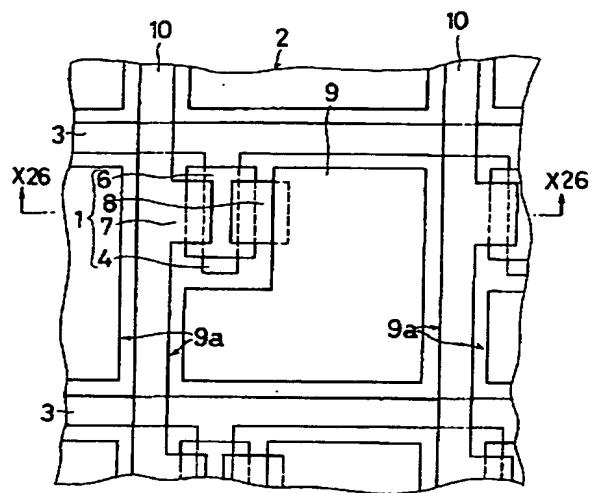
【図23】



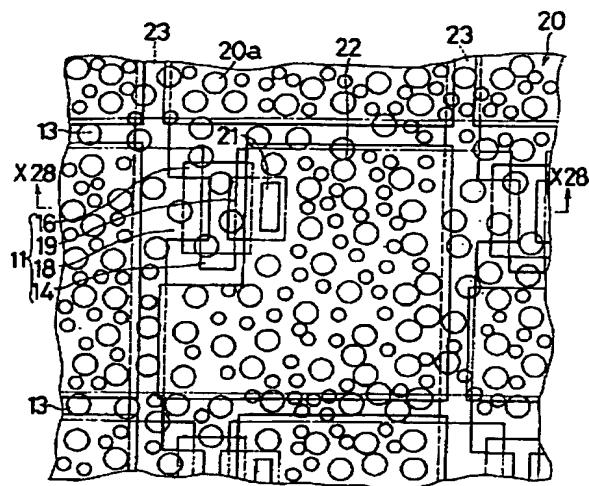
【図24】



【図25】



【図27】



フロントページの続き

(72) 発明者 神戸 誠
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

(72) 発明者 島田 康憲
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内